

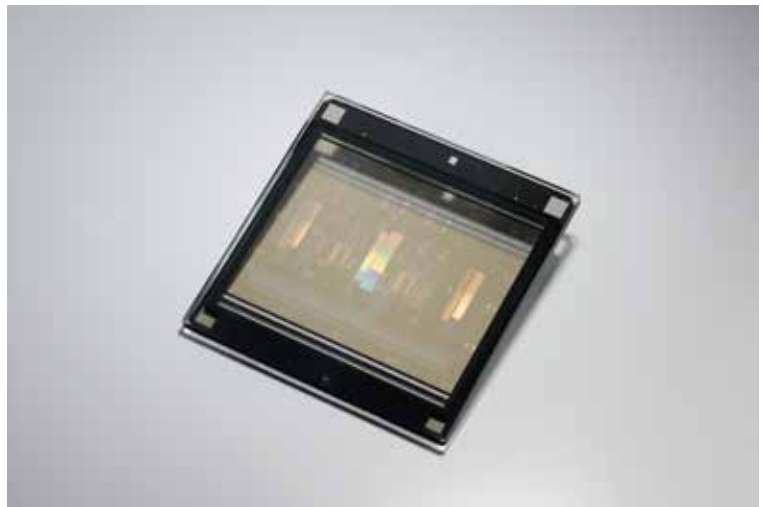
光掩模

光掩模是用於 LSI 等集成電路製造工序的重要器件。

在透明玻璃板表面的遮光膜上蝕刻加工了非常微細的電路圖案，成為對矽晶圓複刻電路時的原版。

光掩模的供貨業績實例

- 半導體器件用途
- 光導波路、光學裝置用途
- MEMS用途
- LED用途
- 微透鏡用途
- 設備精度控制用途
- 校準器用途
- 光刻機用途
- 光致抗蝕劑評估用途
- 分辯率評估用途 等



數據格式

- MEBES
- JEOL
- MIC
- VSB
- Gerber
- GDS
- DXF
- DWG
- BMP

※ 歡迎洽詢上述以外的格式。

可用尺寸

底板尺寸	厚度	材質	遮光膜材質	遮光膜厚度	可繪圖區域
152 × 152 mm (6 × 6 英寸)	6.35mm (0.25英寸)	Qz	Cr	105nm	146 × 146mm
		Qz	Cr	73nm	146 × 146mm
		Qz	MoSi (KrF-PSM)	(透過率6%@KrF)	146 × 146mm
		Qz	MoSi (ArF-PSM)	(透過率6%@ArF)	146 × 146mm
	3.05mm (0.12英寸)	Qz	Cr	105nm	146 × 146mm
	2.30mm (0.09英寸)	Qz	Cr	105nm	146 × 146mm
127 × 127mm (5 × 5 英寸)	4.60mm (0.18英寸)	Qz	Cr	105nm	120 × 120mm
	2.30mm (0.09英寸)	Qz	Cr	105nm	120 × 120mm

光掩模標準規格

鐳射繪圖

項目	規格
	Qz材料
尺寸精度	設計值 $\pm 0.025 \mu\text{m}$
總間距精度	設計值 $\pm 0.070 \mu\text{m}$
定位精度	設計值 $\pm 0.035 \mu\text{m}$
圖案缺陷	0.15 μm 0個
最小尺寸	Line圖案 0.7 μm , Hole圖案 1.0 μm

50kv電子束繪圖

項目	規格
	Qz材料
尺寸精度	設計值 $\pm 0.015 \mu\text{m}$
總間距精度	設計值 $\pm 0.050 \mu\text{m}$
總間距精度	設計值 $\pm 0.025 \mu\text{m}$
圖案缺陷	0.10 μm 0個
最小尺寸	Line圖案 0.4 μm , Hole圖案 0.6 μm

※ 歡迎洽詢上述以外的格式。